SIC CARRIER

碳化矽承載盤

SiC 承載盤 · SiC Susceptor/SiC carrier

Silicon Carbide (SiC) Carrier

碳化矽承載盤（SiC 承載盤）是晶圓解鍵合時托住晶圓的透氣載盤，用在下蠟機與晶圓分離設備。適合三五族與第三代半導體這類薄、脆的晶圓製程。

應用於晶圓分離、下蠟機（De-mounter；De-Bonder），三五族與第三代半導體晶圓代工。



FUNCTION

產品功能

隨著晶片越做越薄，加上 SiC 等硬度高、較脆、容易碎裂的化合物半導體普及，晶圓製程中必須把脆弱的晶圓放在其他臨時的承載晶圓 / 基板上加工，完成後再將兩者分離。

III-V 族晶圓經背面研磨減薄後，進行微影、金屬化、蝕刻等工藝；之後使用基座加熱到所需溫度，讓鍵合蠟溶解，再由上下真空吸盤建立真空吸力，以步進馬達驅動向前移動，使承載盤與晶圓分離。

透氣結構 Porosity 25 ± 2%

碳化矽透氣承載盤，用於解鍵合（Debond）製程。

SPECIFICATION

產品規格

材質 Material	碳化矽（SiC）
尺寸 Dimension	Ø4～8"，厚度 0.7～1 mm（公差 ± 0.1 mm）
孔隙率 Porosity	25 ± 2%
密度 Density	3.2 g/cm³
平面度 Flatness	依需求客製 / 洽詢

孔隙率、密度等材料特性取自 Ø96×1 mm 承載盤規格表；其他尺寸請來信洽詢。

APPLICATIONS

應用

應用設備

晶圓分離　下蠟機（De-mounter；De-Bonder）

應用領域

三五族晶圓代工　第三代半導體晶圓代工